

ЭФФЕКТЫ УВЛЕЧЕНИЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗДЕЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ЭКСИТОНОВ

Ю. Е. Лозовик*, М. В. Никитков

Институт спектроскопии Российской академии наук
142092, Троицк, Московская обл., Россия

Поступила в редакцию 3 сентября 1996 г.

Рассматриваются эффекты увлечения в двухслойной системе пространственно-разделенных электронов и экситонов: увлечение экситонов движущимися электронами и увлечение электронов движущимися экситонами. Для случая увлечения экситонов электронами найдена скорость увлечения v_{drag} , а для случая увлечения электронов экситонами рассчитана напряженность индуцированного электрического поля E_2 . Описанные эффекты увлечения могут быть чувствительным индикатором фазового состояния экситонов и фазовых переходов в системе экситонов (в жидкую фазу, в сверхтекучее состояние и т.п.).

1. ВВЕДЕНИЕ

Теоретическое предсказание эффекта увлечения в двухслойной системе пространственно-разделенных электронов и дырок и исследование влияния фазового перехода в сверхтекучую экситонную фазу было сделано в [1] (см. также [2] и цитируемую литературу). Позднее в [3] был рассмотрен эффект увлечения электронов электронами в системе типа полупроводник–диэлектрик–полупроводник. Практический способ наблюдения эффекта увлечения в гетероструктурах был предложен в [4]. В дальнейшем эффект увлечения получил развитие в ряде теоретических и экспериментальных работ [5–13]. Были рассмотрены различные физические реализации эффекта увлечения в одномерных, двумерных и трехмерных системах.

В данной работе рассматриваются новые эффекты: увлечение в двухслойной системе пространственно-разделенных электронов и экситонов. Из-за электронейтральности экситонов исследование их транспортных свойств представляет большие трудности. До сих пор о транспортных свойствах экситонов можно было судить с помощью локального исследования их излучения при рекомбинации [14]. Поэтому было бы интересно исследовать увлечение электронов экситонами, движущимися за счет градиента концентрации. Увлечение в данном случае обусловлено взаимодействием экситона с поляризующим его электроном. Рассмотренный нами эффект дает принципиальную возможность по результатам измерения тока или напряжения увлекаемых электронов судить о транспортных свойствах экситонов и их изменении в результате фазовых переходов в системе экситонов. Мы рассмотрели также обратный эффект в системе пространственно-разделенных электронов и экситонов, а именно, увлечение экситонов движущимися электронами. Этот эффект дает принципиальную возможность с помощью изменения

* E-mail: lozovik@isan.msk.su

напряжения в электронном слое управлять движением экситонов. Разумеется, рассмотренные нами эффекты будут иметь место и для электронов и экситонов в одном слое. Полученные нами результаты качественно справедливы и для этого случая.

Взаимодействие между электроном и экситоном слабее, чем взаимодействие между двумя заряженными частицами. Следовательно, эффект увлечения в электрон-экситонной системе будет менее выражен, чем эффект увлечения в электронной системе. Это обстоятельство приведет к сложностям в экспериментальном обнаружении эффекта увлечения в системе электронов и экситонов, однако можно надеяться, что данный эффект все же будет обнаружен.

В данной работе решена система двух уравнений Больцмана для функций распределения электронов и экситонов. Найдена скорость v_{drag} , которую приобретают экситоны, взаимодействуя с движущимися электронами. Получено выражение для напряженности электрического поля E_2 , которое возникает в электронной системе благодаря эффекту увлечения электронов экситонами.

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ УВЛЕЧЕНИЯ

Рассмотрим структуру типа двойной квантовой ямы. Пусть в одной из ям (обозначим ее индексом 1) лазером созданы экситоны с неоднородностью плотности (например, за счет применения непроницаемой для лазерного излучения маски, фокусирования и т. п.). В другой яме (обозначим ее индексом 2) имеется газ электронов с плотностью n_2 . Ширину барьера между ямами обозначим d . В рассматриваемой задаче туннелирование учитывать не будем. Наша цель — вычислить отклик системы экситонов на внешнее электрическое поле, приложенное к системе электронов, а также отклик электронной системы на воздействие со стороны системы экситонов.

В двухслойной системе электронов и экситонов поток массы экситонов $\mathbf{i} = m_1 n_1 \mathbf{v}_1$ и поток заряда электронов $\mathbf{j} = -en_2 \mathbf{v}_2$ могут быть выражены через градиент концентрации экситонов ∇n_1 и внешнее электрическое поле E_2 , приложенное к электронной подсистеме, следующим образом

$$\mathbf{J} = \hat{K} \mathbf{S}, \quad (1)$$

где

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} i_1 \\ j_2 \end{pmatrix}, \quad \hat{K} = \begin{pmatrix} -m_1 D_{11} & -n_1 m_1 \mu_{12} \\ em_1 D_{21}/m_2 & en_2 \mu_{22} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \nabla n_1 \\ E_2 \end{pmatrix}.$$

Здесь D_{11} — коэффициент диффузии экситонов; D_{21} — коэффициент взаимной диффузии экситонов и электронов; μ_{12} — коэффициент взаимной подвижности экситонов и электронов; μ_{22} — коэффициент подвижности электронов.

Отметим, что в рассматриваемой двухслойной системе коэффициенты D_{11} и μ_{22} (так же, как D_{21} и μ_{12}) учитывают взаимодействие между электронами и экситонами.

В случае, когда к слою электронов не приложено внешнее электрическое поле и он не включен в замкнутую цепь, но в экситонной системе создан градиент концентрации, в электронном слое возникает индуцированное электрическое поле E_2^{ind} , равное

$$E_2^{ind} = -\frac{m_1 D_{21}}{m_2 n_2 \mu_{22}} \nabla n_1 = -K_{21} \nabla n_1. \quad (2)$$

Для потока экситонов в этом случае получаем из (1)

$$\mathbf{i}_1 = -(m_1 D_{11} - n_1 m_1 \mu_{12} K_{21}) \nabla n_1. \quad (3)$$

Если же $\nabla n_1 = 0$, то для потока экситонов имеем

$$\mathbf{i}_1 = -n_1 m_1 \mu_{12} \mathbf{E}_2, \quad (4)$$

при этом скорость экситонов, как следует из (4), есть

$$\mathbf{v}_1 = -\mu_{12} \mathbf{E}_2. \quad (5)$$

3. УВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ЭКСИТОНАМИ

Благодаря наличию неоднородной концентрации экситоны будут диффундировать в направлении ее уменьшения. Взаимодействуя при своем движении с электронами, экситоны передадут им некоторый импульс; в результате этого возникает индуцированное электрическое поле \mathbf{E}_2 в электронном слое.

Рассмотрим случай, когда цепь, включающая электронный слой, разомкнута. Кинетические уравнения для функций распределения экситонов и электронов имеют вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1 = I_1 + I_{12}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{r}_2} \mathbf{v}_2 + \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 = I_{21}, \quad (7)$$

где I_1 — интеграл столкновений, учитывающий все процессы рассеяния экситонов, исключая рассеяние экситонов на электронах, а I_{12} — интеграл столкновений, учитывающий рассеяние экситонов на электронах. В уравнении (6) отсутствует член с производной по импульсу $(\partial f_1 / \partial \mathbf{p}_1) \dot{\mathbf{p}}_1$. Равенство нулю этого члена связано с тем, что на экситоны не действуют силы макроскопического характера и $\dot{\mathbf{p}}_1 = 0$. В случае, когда цепь, включающая электронный слой, разомкнута, интеграл столкновений электронов в пленке 2, I_2 , равен нулю и в равновесии возникает индуцированное электрическое поле \mathbf{E}_2 , которое компенсирует изменение импульса электронов в результате электрон-экситонных столкновений. Систему уравнений (6) и (7) можно упростить, если считать, что электрон-экситонное взаимодействие слабо влияет на процесс диффузии экситонов, так что $|I_1| \gg |I_{12}|$ и член I_{12} можно опустить. Если неоднородность в распределении электронов мала, т. е.

$$\left| \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{r}_2} \mathbf{v}_2 \right| \ll \left| \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 \right|,$$

то ей также можно пренебречь. Тогда получим

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1 = I_1, \quad (8)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 = I_{21}. \quad (9)$$

Перепишем левую часть уравнения (8) в виде (считаем, что $n_1 = n_1(x)$)

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1 = \frac{\partial f_1}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial n_1} \frac{\partial n_1}{\partial x} v_{1x} + \frac{\partial f_1}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1, \quad (10)$$

где $\mu = \mu(x)$ — химический потенциал экситонного газа. Градиентом температуры будем пренебрегать. Интеграл столкновений I_1 запишем в τ -приближении:

$$I_1 = -\frac{f_1 - f_1^0}{\tau_1}, \quad (11)$$

где τ_1 — время релаксации экситонов, f_1^0 — функция Бозе с $\mu = \mu(n_{10}) = \mu_0$, нормированная следующим образом:

$$n_{10} = \int f_1^0 \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (12)$$

В результате уравнение (8) примет следующий вид:

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mu} \frac{\partial \mu}{\partial n_1} \frac{\partial n_1}{\partial x} v_{1x} = -\frac{f_1 - f_1^0}{\tau_1}. \quad (13)$$

Линеаризуем уравнение (13); для этого запишем $n_1(x) = n_{10} + \delta n_1(x)$, $\mu(n_1) = \mu(n_{10}) + \delta\mu(x)$, а f_1 представим в виде

$$f_1 = f_1^0 + f_1^0(1 + f_1^0)\psi_1. \quad (14)$$

В результате для ψ_1 получим выражение

$$\psi_1 = -\frac{\tau_1}{k_B T} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \frac{\partial n_1}{\partial x} v_{1x}. \quad (15)$$

Столкновения экситонов с электронами будем считать упругими. Интеграл столкновений в уравнении (9) имеет вид

$$I_{21} = \sum_{\sigma_1'} \int w(\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2; \mathbf{p}_1' \mathbf{p}_2') \{ f_1' f_2' (1 + f_1)(1 - f_2) - f_1 f_2 (1 + f_1')(1 - f_2') \} \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1' - \varepsilon_2') \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2'}{(2\pi\hbar)^2}, \quad (16)$$

где w — вероятность рассеяния экситона на электроне.

Линеаризуем уравнение (9). Для этого запишем f_2 в виде, аналогичном (14), т.е.

$$f_2 = f_2^0 + f_2^0(1 - f_2^0)\psi_2, \quad (17)$$

где f_2^0 — функция Ферми, удовлетворяющая условию нормировки

$$n_2 = 2 \int f_2^0 \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (18)$$

Учитывая, что $\dot{\mathbf{p}}_2 = -e\mathbf{E}_2$, получим

$$-e\mathbf{E}_2 \frac{\partial f_2^0}{\partial \mathbf{p}_2} = \sum_{\sigma_2'} \int w \{ f_1^0 f_2^0 (1 + f_1^0) (1 - f_2^0) \} \times \\ \times (\psi_{1'} + \psi_{2'} - \psi_1 - \psi_2) \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_{2'}}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (19)$$

В случае отсутствия тока в электронном слое ψ_2 и $\psi_{2'}$ равны нулю. Умножим обе части уравнения (19) на $p_{2x}/(2\pi\hbar)^2$, проинтегрируем по всем импульсам \mathbf{p}_2 и просуммируем по проекциям спина σ_2 . Тогда уравнение (19) можно записать в виде

$$E_2 = -K_{21} \nabla_x n_1, \quad (20)$$

где коэффициент K_{21} (см. формулу (2)) равен

$$K_{21} = \frac{2\tau_1}{em_1 n_2 k_B T} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \int w f_1^0 f_2^0 (1 + f_1^0) (1 - f_2^0) \times \\ \times p_{2x} (p_{1'x} - p_{1x}) \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_{2'}}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (21)$$

Учитывая закон сохранения импульса при столкновении: $p_{1x} - p_{1'x} = p_{2'x} - p_{2x}$, а также симметрию интеграла в выражении (21), получим

$$K_{21} = \frac{\tau_1}{2em_1 n_2 k_B T} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \int w f_1^0 f_2^0 (1 + f_1^0) (1 - f_2^0) \times \\ \times q^2 \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_{2'}}{(2\pi\hbar)^2}, \quad (22)$$

где $\mathbf{q} = \mathbf{p}_{2'} - \mathbf{p}_2$.

Для вероятности рассеяния экситона на электроне будем использовать борновское приближение:

$$w(\mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2; \mathbf{p}_{1'} \mathbf{p}_{2'}) = \frac{2\pi}{\hbar} |U(\mathbf{q})|^2, \quad (23)$$

где $U(\mathbf{q})$ — фурье-образ эффективной энергии взаимодействия экситона и электрона (см. разд. 5).

Использование борновского приближения в данном случае оправдано, так как условие его применимости имеет вид

$$\gamma n^{3/2} \ll \hbar v, \quad \text{если } d < n^{-1/2},$$

$$\gamma d^{-3} \ll \hbar v, \quad \text{если } d > n^{-1/2},$$

где $n = \max\{n_1, n_2\}$, величина γ определяется ниже формулой (71), v — относительная скорость электрона и экситона. Это условие выполняется в широком интервале концентраций и температур. Например, при радиусе экситона $a = 20$ Å, диэлектрической постоянной среды $\epsilon = 10$ и $d < n^{-1/2}$, получим условие $n^{3/2}/v \ll 10^{13} \text{ см}^{-4} \cdot \text{с}$.

Используя тождество

$$\delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) = \int d(\hbar\omega) \delta(\varepsilon_1 - \varepsilon_{1'} - \hbar\omega) \delta(\varepsilon_2 - \varepsilon_{2'} + \hbar\omega), \quad (24)$$

получим выражение для коэффициента K_{21} в другой форме:

$$\begin{aligned} K_{21} = & \frac{1}{2} \frac{\tau_1}{e\hbar^2 k_B T m_1 n_2} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \int_0^\infty U^2(q) q^3 dq \times \\ & \times \int_{-\infty}^\infty d\omega \int_{-\infty}^\infty f_1^0 (1 + f_{1'}^0) \delta(\varepsilon_1 - \varepsilon_{1'} - \hbar\omega) \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \times \\ & \times \int_{-\infty}^\infty f_2^0 (1 - f_{2'}^0) \delta(\varepsilon_2 - \varepsilon_{2'} + \hbar\omega) \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \end{aligned} \quad (25)$$

Перепишем выражение (25) в виде

$$\begin{aligned} K_{21} = & \frac{1}{8\pi^2} \frac{\tau_1}{e\hbar^2 k_B T m_1 n_2} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \int_0^\infty U^2(q) q^3 dq \times \\ & \times \int_{-\infty}^\infty \frac{\text{Im} \chi^B(q, \omega) \text{Im} \chi^F(q, \omega)}{\text{sh}^2(\hbar\omega/2k_B T)} d\omega, \end{aligned} \quad (26)$$

где

$$\chi^B(q, \omega) = - \int \frac{f^0(\varepsilon_1) - f^0(\varepsilon_{1'})}{(\varepsilon_1 - \varepsilon_{1'} + \hbar\omega + i\delta)} \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2}, \quad (27)$$

$$\chi^F(q, \omega) = - \int \frac{f^0(\varepsilon_2) - f^0(\varepsilon_{2'})}{(\varepsilon_2 - \varepsilon_{2'} + \hbar\omega + i\delta)} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (28)$$

Пусть параметры системы таковы, что распределение экситонов и электронов является бoльцмановским. В этом случае для K_{21} находим из (25) более простое выражение:

$$K_{21} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{\tau_1 n_{10}}{e m_1} \sqrt{\frac{M}{(k_B T)^3}} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \int_0^\infty U^2(k) k^2 \exp\left(-\frac{k^2 \hbar^2}{8M k_B T}\right) dk, \quad (29)$$

где $M = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$, $k = q/\hbar$, U — потенциальная энергия взаимодействия электронов с экситонами.

Выразим теперь E_2 через скорость диффузии экситонов v_{diff} . Для этого найдем v_{diff} :

$$v_{diff} = \frac{1}{n_{10}} \int v_{1x} f_1^0 \psi_1 \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (30)$$

С учетом выражения (15) получим из (30)

$$v_{diff} = - \frac{\tau_1}{m_1} \frac{\partial \mu_0}{\partial n_{10}} \frac{\partial n_1}{\partial x}. \quad (31)$$

Запишем уравнение для E_2 в виде

$$E_2 = \lambda_{21} v_{diff}. \quad (32)$$

Используя (29), для λ_{21} получим выражение

$$\lambda_{21} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{n_{10}}{e} \sqrt{\frac{M}{(k_B T)^3}} \int_0^\infty U^2(k) k^2 \exp\left(-\frac{k^2 \hbar^2}{8Mk_B T}\right) dk. \quad (33)$$

4. УВЛЕЧЕНИЕ ЭКСИТОНОВ ЭЛЕКТРОНАМИ

Рассмотрим обратную ситуацию, когда электроны увлекают экситоны. Рассчитаем скорость, которую получают экситоны при взаимодействии с электронами.

Кинетические уравнения в этом случае имеют вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1 = I_1 + I_{12}, \quad (34)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{r}_2} \mathbf{v}_2 + \frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 = I_2 + I_{21}. \quad (35)$$

Для упрощения уравнений (34) и (35) будем считать, что ток электронов является однородным, а также, что интеграл столкновений I_{21} является малой добавкой к I_2 ; тогда в уравнении (35) им можно пренебречь. Кроме того, будем интересоваться только скоростью увлечения v_{drag} , считая ее преобладающей над скоростью диффузии v_{diff} ; тогда в уравнении (34) можно опустить член с производной f_1 по координате. С учетом этого получим

$$I_1 + I_{12} = 0, \quad (36)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 = I_2. \quad (37)$$

Как обычно, подставив в уравнение (37) f_2 в виде (17) и используя τ -приближение для I_2 , находим

$$\psi_2 = -\frac{\tau_2}{m_2 k_B T} e \mathbf{E}_2 \mathbf{p}_2. \quad (38)$$

Здесь $\mathbf{E}_2 = \{E_2, 0\}$ — напряженность внешнего электрического поля, τ_2 — время релаксации электронов.

Уравнение (36) напишем более подробно:

$$I_1 = - \sum_{\sigma_1, \sigma_1'} \int w \{f_{1'} f_{2'} (1 + f_1)(1 - f_2) - f_1 f_2 (1 + f_{1'}) (1 - f_{2'})\} \times \\ \times \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_{1'}}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (39)$$

Подставив в (39) f_1 в виде (14) и f_2 в виде (17), а также $I_1 = -(f_1 - f_1^0)/\tau_1$, получим линеаризованное уравнение

$$f_1^0(1 + f_1^0)\psi_1 = 2\tau_1 \int w f_1^0 f_2^0 (1 + f_1^0)(1 - f_2^0)(\psi_{1'} + \psi_{2'} - \psi_1 - \psi_2) \times \\ \times \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_{1'}}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (40)$$

Условие $v_{diff} \ll v_{drag}$ дает право опустить члены ψ_1 и $\psi_{1'}$, стоящие под интегралом в выражении (40).

Выражение для скорости увлечения имеет вид

$$v_{drag} = \frac{1}{m_1 n_{10}} \int p_{1x} f_1^0 (1 + f_1^0) \psi_1 \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (41)$$

Запишем уравнение для v_{drag} (см. (5)) в виде

$$v_{drag} = -\mu_{12} E_2. \quad (42)$$

С учетом равенств (40) и (41) имеем для μ_{12}

$$\mu_{12} = \frac{2e\tau_1\tau_2}{m_1 m_2 n_{10} k_B T} \int w f_1^0 f_2^0 (1 + f_1^0)(1 - f_2^0) \times \\ \times p_{1x} (p_{2'x} - p_{2x}) \delta(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_{1'} - \varepsilon_{2'}) \frac{d\mathbf{p}_1}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_{1'}}{(2\pi\hbar)^2} \frac{d\mathbf{p}_2}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (43)$$

Опуская выкладки, аналогичные тем, которые были проведены выше, окончательно находим выражение для μ_{12} :

$$\mu_{12} = \frac{1}{8\pi^2} \frac{\tau_1\tau_2}{m_1 m_2 n_{10} \hbar^2} \frac{e}{k_B T} \int_0^\infty dq \int_{-\infty}^\infty d\omega U^2(q) q^3 \frac{\text{Im} \chi^B(q, \omega) \text{Im} \chi^F(q, \omega)}{\text{sh}^2(\hbar\omega/2k_B T)}, \quad (44)$$

или в классическом случае

$$\mu_{12} = \frac{\tau_1\tau_2}{4\sqrt{2}\pi} \frac{en_2}{m_1 m_2} \sqrt{\frac{M}{(k_B T)^3}} \int_0^\infty U^2(k) k^2 \exp\left(-\frac{k^2 \hbar^2}{8Mk_B T}\right) dk. \quad (45)$$

5. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭЛЕКТРОН-ЭКСИТОННОЙ СИСТЕМЕ

Для расчета эффективной энергии взаимодействия в двухслойной системе электронов и экситонов будем использовать самосогласованное приближение. Величины, относящиеся к экситонам, обозначим индексом 1, а относящиеся к электронам — индексом 2. Если радиус экситона много меньше расстояния между электроном и экситоном, то энергия взаимодействия изолированных электрона и экситона имеет вид

$$V_{e-ex}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, d) = -\frac{\gamma}{[(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 + d^2]^2},$$

где $\gamma = \alpha e^2/2\epsilon$, α — поляризуемость двумерного экситона в основном состоянии, d — расстояние между слоями, $|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ — расстояние между экситоном и электроном вдоль слоев, ϵ — диэлектрическая проницаемость среды. При выводе выражения для эффективной энергии взаимодействия в многочастичной электрон-экситонной системе будем считать, что экситон-экситонное взаимодействие пренебрежимо мало по сравнению с электрон-экситонным и учитывать его не будем. Поместим пробный заряд $-e$ в электронную подсистему в точку начала координат. Линеаризованные кинетические уравнения для функций распределения экситонов и электронов имеют вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}_1} \mathbf{v}_1 + \frac{\partial f_1^0}{\partial \mathbf{p}_1} \dot{\mathbf{p}}_1 = 0, \quad (46)$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial \mathbf{r}_2} \mathbf{v}_2 + \frac{\partial f_2^0}{\partial \mathbf{p}_2} \dot{\mathbf{p}}_2 = 0, \quad (47)$$

где

$$\dot{\mathbf{p}}_1 = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_1} U(\mathbf{r}_1, d), \quad \dot{\mathbf{p}}_2 = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_2} U(\mathbf{r}_2, 0).$$

Энергии взаимодействия $U(\mathbf{r}, 0)$ и $U(\mathbf{r}, d)$ подчиняются следующим уравнениям:

$$U(\mathbf{r}, 0) = \int \rho_2(\mathbf{r}') \frac{e^2}{\epsilon|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' - \int \frac{\gamma \rho_1(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'}{[(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2 + d^2]^2} + \frac{e^2}{\epsilon r}, \quad (48)$$

$$U(\mathbf{r}, d) = - \int \frac{\gamma \rho_2(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'}{[(\mathbf{r} - \mathbf{r}')^2 + d^2]^2} - \frac{\gamma}{(r^2 + d^2)^2}, \quad (49)$$

где

$$\rho_1(\mathbf{r}) = \int f_1(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2}, \quad \rho_2(\mathbf{r}) = 2 \int f_2(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2}.$$

Переходя в уравнениях (46)–(49) к фурье-компонентам, получим (считаем, что $\mathbf{k} = \{k, 0\}$)

$$f_1(\mathbf{k}, \mathbf{p}) = \frac{1}{v_{1x}} \frac{\partial f_1^0}{\partial p_{1x}} U(\mathbf{k}, d), \quad (50)$$

$$f_2(\mathbf{k}, \mathbf{p}) = \frac{1}{v_{2x}} \frac{\partial f_2^0}{\partial p_{2x}} U(\mathbf{k}, 0), \quad (51)$$

где f_1^0 — функция Бозе, а f_2^0 — функция Ферми;

$$U(\mathbf{k}, 0) = \frac{4\pi e^2}{\epsilon k} \int f_2(\mathbf{k}, \mathbf{p}) \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2} - \gamma F(\mathbf{k}, d) \int f_1(\mathbf{k}, \mathbf{p}) \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2} + \frac{2\pi e^2}{\epsilon k}, \quad (52)$$

$$U(\mathbf{k}, d) = -2\gamma F(\mathbf{k}, d) \int f_2(\mathbf{k}, \mathbf{p}) \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2} - \gamma F(\mathbf{k}, d), \quad (53)$$

функция $F(\mathbf{k}, d) = (\pi k/d) K_1(kd)$, а $K_1(z)$ — функция Макдональда.

Из уравнений (50)–(53) получаем систему двух алгебраических уравнений для определения $U(k, 0)$ и $U(k, d)$:

$$U(k, 0) = \frac{2\pi e^2}{\epsilon k} \beta_2 U(k, 0) - \gamma \beta_1 F(k, d) U(k, d) + \frac{2\pi e^2}{\epsilon k}, \quad (54)$$

$$U(k, d) = -\gamma \beta_2 F(k, d) U(k, 0) - \gamma F(k, d), \quad (55)$$

где

$$\beta_1 = \int \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_1^0}{\partial p_x} \frac{dp}{(2\pi\hbar)^2}, \quad \beta_2 = 2 \int \frac{1}{v_x} \frac{\partial f_2^0}{\partial p_x} \frac{dp}{(2\pi\hbar)^2}. \quad (56)$$

Если f_1^0 и f_2^0 — распределения Больцмана, то

$$\beta_1 = -\frac{n_{10}}{k_B T}, \quad \beta_2 = -\frac{n_2}{k_B T}; \quad (57)$$

если f_2^0 — фермиевская ступенька, то

$$\beta_2 = -\frac{m_2}{\pi\hbar^2}. \quad (58)$$

В результате выражение для эффективной энергии взаимодействия в многочастичной электрон-экситонной системе имеет вид

$$U(k, d) = -\frac{\gamma F(k, d)}{1 - 2\pi e^2 \beta_2 / \epsilon k - \gamma^2 \beta_1 \beta_2 F^2}. \quad (59)$$

В однослойной системе электронов и экситонов выражение для эффективной энергии взаимодействия имеет такой же вид лишь с заменой функции $F(k, d)$ на функцию $F(k, a)$, определенную следующим образом:

$$F(k, a) = \int \frac{e^{-ikr} dr}{r^4} = 2\pi \int_a^\infty \frac{J_0(kr) dr}{r^3},$$

где a — радиус экситона, J_0 — функция Бесселя.

Определяя таким образом функцию $F(k, a)$, считаем, что взаимодействие между электроном и экситоном является диполь-зарядным на расстояниях вплоть до размера экситона и равным нулю при меньших расстояниях.

Приведем теперь значение параметра $\gamma = \alpha e^2 / 2\epsilon$, входящего в формулу (59).

Энергия взаимодействия экситона в основном состоянии с электроном во втором порядке теории возмущений по оператору электрон-экситонного взаимодействия $\hat{V} = -\mathbf{dE} = -e\mathbf{dR}/\epsilon R^3$ ($\mathbf{d} = e\mathbf{r}$ — дипольный момент экситона, R — расстояние между электроном и экситоном) имеет вид

$$W = \sum_k' \frac{|V_{0k}|^2}{E_0 - E_k} = \frac{e^4}{\epsilon^2 R^4} \sum_k' \frac{|x_{0k}|^2}{E_0 - E_k} = -\frac{\alpha e^2}{2\epsilon R^4}. \quad (60)$$

Этим выражением мы воспользовались при вычислении эффективного взаимодействия в многочастичной электрон-экситонной системе. Вычислим теперь входящую в параметр γ поляризуемость α двумерного экситона:

$$\alpha = -\frac{2e^2}{\epsilon} \sum_k' \frac{|x_{0k}|^2}{E_0 - E_k}. \quad (61)$$

Введем вспомогательный оператор \hat{b} следующим образом [15]:

$$x = \frac{m_1}{\hbar} \frac{d\hat{b}}{dt}. \quad (62)$$

Тогда для α получим выражение

$$\alpha = \frac{2im_1e^2}{\epsilon\hbar^2} (x\hat{b})_{00}. \quad (63)$$

Рассмотрим действие оператора \hat{b} на волновую функцию ψ_0 основного состояния экситона:

$$x\psi_0 = \frac{m_1}{\hbar} \frac{d\hat{b}}{dt} \psi_0 = \frac{im_1}{\hbar^2} (\hat{H}\hat{b} - \hat{b}\hat{H})\psi_0, \quad (64)$$

где \hat{H} — гамильтониан системы.

Пусть $\hat{b}\psi_0 = b(\mathbf{r})\psi_0$. С учетом равенства $[-\hbar^2\nabla^2/2m_1 + U(r)]\psi_0 = E_0\psi_0$ уравнение (64) примет вид

$$ix\psi_0 = \frac{1}{2} \nabla^2 b(\mathbf{r})\psi_0 + \nabla b(\mathbf{r})\nabla\psi_0. \quad (65)$$

Подстановкой $b(\mathbf{r}) = f(r) \cos \phi$ уравнение (65) приводится к виду

$$ir = \frac{1}{2} f'' + \frac{1}{2} \frac{f'}{r} - \frac{1}{2} \frac{f}{r^2} + f' \frac{\psi_0'}{\psi_0}. \quad (66)$$

Волновая функция основного состояния двумерного экситона есть

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-r/a}, \quad (67)$$

$a = \epsilon\hbar^2/2m_1e^2$ — радиус двумерного экситона в основном состоянии, $m_1 = m_e m_h / (m_e + m_h)$, m_e и m_h — массы электрона и дырки.

Решая уравнение (66) с учетом (67), получим

$$f = A\left(1 + \frac{a}{2r}\right) + B \frac{e^{2r/a}}{r} - \frac{ia}{2} \left(r^2 + \frac{3ar}{2} + \frac{3a^2}{2} + \frac{3a^3}{4r} \right). \quad (68)$$

Коэффициенты A и B выбираются из условия конечности $f\psi_0$ при $r \rightarrow 0$ и $r \rightarrow \infty$. В результате решение приобретает вид

$$f = -\frac{ia}{2} \left(r^2 + \frac{3ar}{2} \right). \quad (69)$$

Для поляризуемости α получим с учетом (63) и (67)

$$\alpha = \frac{21}{8} \frac{m_1 e^2}{\epsilon \hbar^2} a^4 = \frac{21}{16} a^3. \quad (70)$$

Таким образом, параметр γ , входящий в выражение (59) для эффективной энергии взаимодействия в многочастичной электрон-экситонной системе, равен

$$\gamma = \frac{21}{32} \frac{e^2 a^3}{\epsilon}. \quad (71)$$

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсудим возможные варианты экспериментов по увлечению экситонов электронами и электронами экситонами. Рассмотрим сначала увлечение электронов экситонами. Направленный поток экситонов можно получить, если локально создать экситоны (например, с помощью лазера с непрерывной накачкой) на одном из краев слоя 1. Экситоны будут диффундировать в противоположном градиенту концентрации направлении от края слоя. В процессе диффузии экситоны будут частично рекомбинировать, а также взаимодействовать с электронами во втором слое. Откликом электронной подсистемы на диффузию экситонов будет либо индуцированный ток электронов, либо индуцированное электрическое поле (напряжение) в слое 2, которое можно измерить.

В эффекте увлечения экситонов электронами скорость увлечения v_{drag} можно измерить с помощью двух оптических зондов (волокон) или отверстий в непроницаемых масках, находящихся на заданном расстоянии R друг от друга. Эти зонды измеряют интенсивность люминесценции. По временному интервалу между максимумами люминесценции можно определить скорость увлечения экситонов v_{drag} (такой вариант возможен при использовании импульсного лазера). На самом деле в измеряемую скорость экситонов дают вклад как диффузия (связанная с градиентом концентрации), так и эффект увлечения. Однако роль диффузии можно выделить, если измерять скорость движения экситонов, когда нет увлекающего экситоны тока электронов.

Аналогичные постановки экспериментов возможны и в случае, когда электроны и экситоны находятся в одном слое.

В однослойной системе возможно образование довольно мелкого связанного состояния электрона и экситона [16] за счет поляризационного взаимодействия между ними. Энергия связи этого состояния, однако, должна сильно уменьшиться при учете обменного паулиевского отталкивания электрона и экситона, а также за счет экранировки (последнее особенно существенно при концентрации электронов $n_2 > 1/r_1^2$, где r_1^2 — радиус связанного состояния одного электрона на одном экситоне). При температурах больших 0.2 энергии ионизации вышеуказанного состояния последнее не дает вклада в обсуждаемые нами кинетические явления.

Влияние образования связанных состояний электронов и экситонов в двухслойной системе на эффекты увлечения оказывается еще более слабым, так как уже при значении величины $d = 100 \text{ \AA}$ температура ионизации становится меньше 1 К.

Эффекты увлечения, в частности индуцированное экситонами электрическое поле (напряжение) в слое электронов, могут являться чувствительными индикаторами состояния экситонной подсистемы и фазовых переходов в ней. Например, отклик должен сильно изменяться при фазовом переходе двумерной системы экситонов в жидкую

фазу. В частности, возникновение движущихся диэлектрических экситонных капель может привести к импульсам электрического тока в электронном слое.

Интересно было бы исследовать с помощью описанных эффектов увлечения проявление бозе-эйнштейновской статистики экситонов, возникновение бозе-эйнштейновской конденсации экситонов. В двумерной системе экситонов, где бозе-эйнштейновская конденсация отсутствует (в термодинамическом пределе) было бы интересно исследовать, как влияет на увлечение электронов возникновение при низких температурах сначала локальной сверхтекучей плотности (с нескоррелированными фазами), а затем, при температуре перехода Костерлица–Таулеса, глобальной сверхтекучей плотности экситонов. В кроссоверной области, где возникает локальная сверхтекучая плотность, коэффициенты увлечения (взаимная подвижность и взаимная диффузия) должны медленно расти и испытывать скачок в точке перехода Костерлица–Таулеса.

Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований, программ «Физика твердотельных наноструктур» и «Фундаментальная спектроскопия».

Литература

1. Ю. Е. Лозовик, В. И. Юдсон, Письма в ЖЭТФ 22, 556 (1975); ЖЭТФ 71, 738 (1976).
2. Yu. E. Lozovik, Report on Adriatico Res. Conf. on Low-Dim. Electron Systems, ICTP, Trieste (1996), p. 53.
3. М. Б. Погребинский, ФТП, 11, 637 (1977).
4. P. J. Price, Physica B, 117 & 118, 750 (1983).
5. T. J. Gramila, J. P. Eisenstein, A. H. MacDonald et al., Phys. Rev. Lett. 66, 1216 (1991).
6. U. Sivan, P. M. Solomon, and H. Shtrikman, Phys. Rev. Lett. 68, 1196 (1992).
7. T. J. Gramila, J. P. Eisenstein, A. H. MacDonald et al., Phys. Rev. B 47, 12957 (1993).
8. A.-P. Jauho and H. Smith, Phys. Rev. B 47, 4420 (1993).
9. L. Zheng and A. H. MacDonald, Phys. Rev. B 48, 8203 (1993).
10. Yu. M. Sirenko and P. Vasilopoulos, Phys. Rev. B 46, 1611 (1992).
11. H. C. Tso, P. Vasilopoulos, and F. M. Peeters, Phys. Rev. Lett. 68, 2516 (1992).
12. K. Flensberg and B. Yu-K. Hu, Phys. Rev. Lett. 73, 3572 (1994).
13. G. Vignale and A. H. MacDonald, Phys. Rev. Lett. 76, 2786 (1996).
14. L. V. Butov, A. Zrenner, G. Abstreiter et al., Phys. Rev. Lett. 73, 304 (1994).
15. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Квантовая механика*, Наука, Москва (1989).
16. В. С. Бабиченко, М. Н. Киселев, Письма в ЖЭТФ 57, 174 (1993).